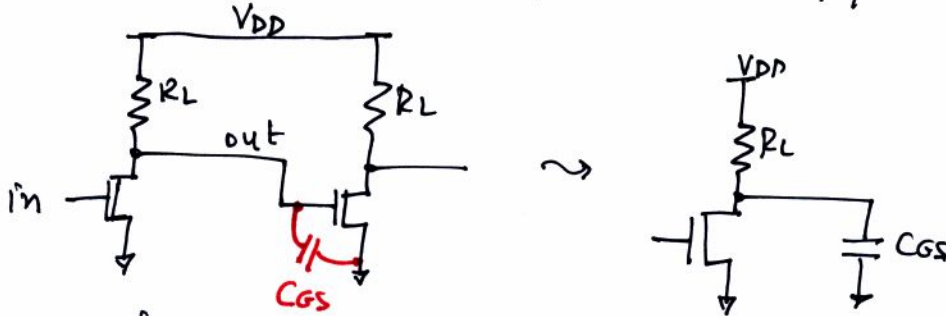
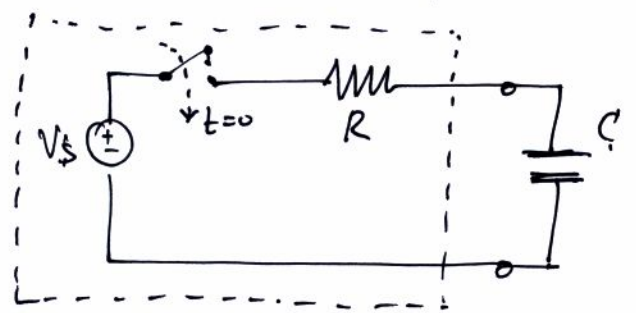


Κατανάλωση Ισχύος στα ψηφιακά κυκλώματα - Οι πύλες CMOS

Στοχοί της ενότητας αυτής είναι να μάθουμε να υπολογίζουμε την κατανάλωση ισχύος των ψηφιακών κυκλωμάτων που σχεδιάζουμε. Για παράδειγμα πότε ισχύ (ή ενέργεια) χοδεύεται ώστε ενώ αντιστροφή να κάνει στην έξοδο του μιας μεταβίβαση από το λογικό-0 στο λογικό-1 ή το αντίστροφο, ώστε να φορτίσει ή να εκφορτίσει



Τη χωρητικότητα εισόδου της επόμενης λογικής πύλης που οδηγεί. Η κατανάλωση ισχύος είναι πολύ εμφαντική παράγοντας κατά τη σχεδίαση. Ουσιαστικά σε μερικές μας καθορίζει πότε ψηφιακά κυκλώματα μας επιτρέπεται να σχεδιάσουμε, ενώ παράλληλα παίζει κύριο ρόλο στην αξιοπιστία των συστημάτων και στο κόστος λειτουργίας τους. Μην ξεχνάτε πως η κατανάλωση ισχύος είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη θερμοκρασία που αναπαύεται στα ολοκληρωμένα κυκλώματα αλλά και με το χρόνο ζωής της μπαταρίας που τροφοδοτεί τη φορητή συσκευή. Πριν αρχίσουμε να αναλύουμε τα ψηφιακά κυκλώματα θα μελετήσουμε αρχικά την κατανάλωση ισχύος στα βασικά κυκλώματα RC ώστε να αποκτίσουμε το απαραίτητο υπόβαθρο.



Τη στιγμή  $t=0$  διακόπτης κλείνει και μένει κλειστός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο πυκνωτής θα φορτιστεί μέχρι την τάση  $V_S$

το οποίο να θα σημαίνει το τέλος των μεταβατικών φαινομένων. Από που θέλουμε να απαντήσουμε είναι πόση είναι η συνολική ενέργεια που χοδεύουμε για να γίνει η μεταβίβαση και ποια στοιχεία του κυκλώματος τη χρησιμοποιήσαν. Ο πυκνωτής αποθηκεύει ενέργεια, ενώ αντίθετα η αντίσταση των μεταβιβάσεων και μόνο (ρίχνει θερμότητα, φως κ-τλ)

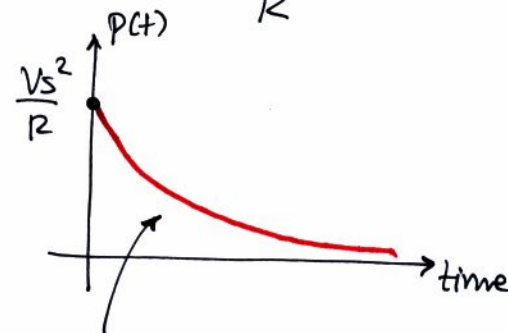
Για να βρούμε την ενέργεια πρέπει να μελετήσουμε την ισχύ των στοιχείων του κυκλώματος. Γνωρίζουμε ότι η στιγμιαία ισχύς που παρέχει η πηγή τάσης στο κύκλωμα είναι το γινόμενο της τάσης επί το ρεύμα που τη διαρρέει.  $P_V(t) = V_S \cdot i(t)$

Το ρεύμα που διαρρέει τον κύκλωμα είναι  $i(t) = \frac{V_S - v_C(t)}{R}$  όπου  $v_C(t)$  η τάση στα άκρα του πυκνωτή εναρμόνιζε τον χρόνο.

Η αρχική τάση στα άκρα του πυκνωτή είναι 0 ενώ η τελική  $V_S$ . Έτσι

$$v_C(t) = V_S + [0 - V_S] e^{-\frac{t}{RC}} = V_S (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

Επομένως  $i(t) = \frac{1}{R} (V_S - V_S (1 - e^{-\frac{t}{RC}})) = \frac{V_S e^{-\frac{t}{RC}}}{R}$ . Έτσι η στιγμιαία ισχύς είναι  $p(t) = \frac{V_S^2}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$ .



Η βωολική ενέργεια που καταναλώθηκε από το κύκλωμα μας δεν είναι τίποτα άλλο από το έργο που περιέχεται πάνω από την καμπύλη της ισχύος. Έτσι η βωολική ενέργεια ~~που~~ αφηρούμε για άπειρο χρόνο το διακόπτη κλειστό είναι:

$$E_{TOTAL} = \int_0^{\infty} p(t) dt = \int_0^{\infty} \frac{V_S^2}{R} e^{-\frac{t}{RC}} dt = \frac{V_S^2}{R} \int_0^{\infty} e^{-\frac{t}{RC}} dt$$

Θυμίζουμε ότι  $\int_{x_1}^{x_2} e^{-ax} dx = \left[ -\frac{1}{a} e^{-ax_2} + \frac{1}{a} e^{-ax_1} \right] = \frac{1}{a} \cdot (e^{-ax_1} - e^{-ax_2})$   
α σταθερά ανεξάρτητη του x

Έτσι  $E_{TOTAL} = \frac{V_S^2}{R} \left[ RC \cdot \left( e^{-\frac{t}{RC}} \Big|_{t=0}^{\infty} - e^{-\frac{t}{RC}} \Big|_{t=0}^{\infty} \right) \right] = \frac{V_S^2}{R} RC = \underline{\underline{C V_S^2}}$

Η βωολική ενέργεια που προσφέρεται από τη πηγή στο κύκλωμα είναι  $E_{TOTAL} = C \cdot V_S^2$ .

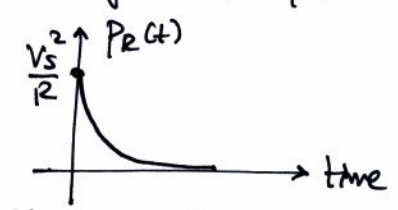
Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε πω αλλά να υπολογιστεί ως εξής: Αρχικά το φορτίο που είχε αποθηκευμένο ο πυκνωτής ήταν 0. Αφού φορτιστεί σε τάση  $V_S$  το φορτίο που έχει αποθηκευτεί είναι  $Q_C = C \cdot V_S$ . Το φορτίο αυτό προήλθε από την πηγή. ( $\Delta Q = Q_{final} - Q_{init} = C \cdot V_S$ ). Η ενέργεια που προσφέρει η πηγή είναι  $\Delta E = \Delta Q \cdot V_S = C \cdot V_S \cdot V_S = \underline{\underline{C V_S^2}}$

Γνωρίζουμε ότι η ενέργεια που αποθηκεύει ο πυκνωτής όταν βρει τάση του ανοικτού  
 μια τάση  $V_s$  είναι ίση με  $E = \frac{1}{2} C V_s^2$ . Η ηχηρή ενέργεια  $E_{\text{TOTAL}} = \frac{1}{2} C V_s^2$  αφού  
 υποθέτουμε πως το υπόλοιπο  $\frac{1}{2} C V_s^2$  καταναλώθηκε στην αντίσταση. Ας  
 το ελέγξουμε: Η στιγμιαία ισχύς που καταναλώνει η αντίσταση είναι  $p_R(t) = v_R(t) \cdot i(t)$

Εφόσον από το νόμο του Ohm  $v_R(t) = i(t) \cdot R$  τότε  $p_R(t) = \frac{v_R^2(t)}{R}$

Η τάση στα άκρα της αντίστασης  $v_R(t) = V_s - v_C(t)$  σύμφωνα με

$v_R(t) = V_s e^{-t/RC}$ . Έτσι  $p_R(t) = \frac{V_s^2}{R} e^{-\frac{2t}{RC}}$



Η βολική λοιπόν ενέργεια που χάθηκε στην  
 αντίσταση είναι

$$E_R = \int_0^{\infty} p_R(t) dt = \frac{V_s^2}{R} \int_0^{\infty} e^{-\frac{2t}{RC}} dt = \frac{V_s^2}{R} \left( \frac{RC}{2} \left( e^{-\frac{2t}{RC}} \Big|_{t=0} - e^{-\frac{2t}{RC}} \Big|_{t=\infty} \right) \right) =$$

$\Rightarrow E_R = \frac{1}{2} C V_s^2$  το οποίο επαληθεύει την αρχική ανάλυση μας.

● Ποια θα ήταν η βολική ενέργεια που θα είχε να προέρχει η ηχηρή τάση ώστε  
 να φορτιστεί πλήρως ο πυκνωτής αν ήταν αρχικά φορτισμένος σε μια τάση  $V_{\text{init}}$ ;  
 Θα απαντήσουμε βάσει το ερώτημα ποιοτικά. Το αρχικό φορτίο που είχε αποθηκευτεί  
 ο πυκνωτής ήταν  $Q_{\text{init}} = C \cdot V_{\text{init}}$ . Το τελικό φορτίο είναι  $Q_{\text{final}} = C \cdot V_s$   
 με τα τη φορτίου του σε μια τάση  $V_s$ . Επομένως, το φορτίο που προέφερε η  
 ηχηρή είναι  $\Delta Q = Q_{\text{final}} - Q_{\text{init}} = C \cdot (V_s - V_{\text{init}})$ . Για να το πωχαι και  
 βγαίνει ότι ζώδεψε ενέργεια, ίση με  $E = \Delta Q \cdot V_s = C \cdot V_s \cdot (V_s - V_{\text{init}})$

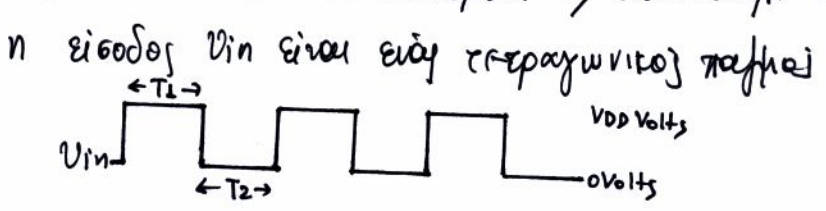
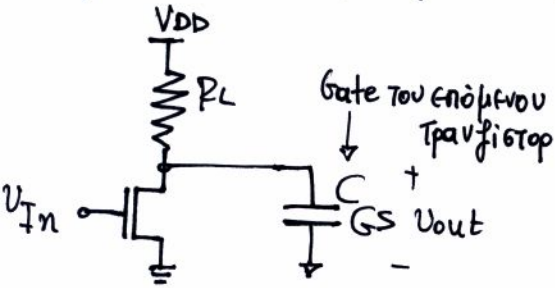
Δηλαδή χρειάστηκε, όπως θα περιμέναμε, λιγότερη ενέργεια σε σχέση με την  
 πρώτη περίπτωση της  $C V_s^2$ . Ποση από αυτή την ενέργεια πήγε στον πυκνωτή;

Αρχικά ο πυκνωτής είχε αποθηκευμένη ενέργεια  $E_{C, \text{init}} = \frac{1}{2} C V_{\text{init}}^2$ , ενώ στο  
 τέλος αποθήκευσε ενέργεια ίση με  $E_{C, \text{final}} = \frac{1}{2} C V_s^2$ . Έτσι η ενέργεια που  
 μεταφέρθηκε στον πυκνωτή είναι  $E_{C, \text{final}} - E_{C, \text{init}} = \frac{1}{2} C V_s^2 - \frac{1}{2} C V_{\text{init}}^2$ . Η  
 διαφορά  $E_{\text{TOTAL}} - E_C$  πήγε στην αντίσταση. Δηλαδή  $E_R = C V_s (V_s - V_{\text{init}}) -$

$$\frac{1}{2} C V_s^2 + \frac{1}{2} C V_{\text{init}}^2 = C V_s^2 - C V_s \cdot V_{\text{init}} - \frac{1}{2} C V_s^2 + \frac{1}{2} C V_{\text{init}}^2 =$$

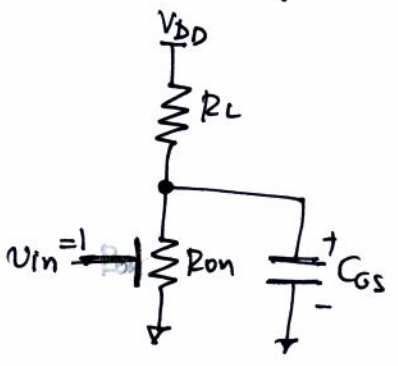
$$> \frac{1}{2} C V_s^2 - C V_s V_{\text{init}} + \frac{1}{2} C V_{\text{init}}^2 = \frac{1}{2} C (V_s - V_{\text{init}})^2$$

Ας επιβεβαιώσουμε τώρα σε ένα απλό ψηφιακό κύκλωμα, όπου είναι αναμενόμενη οδυνηρή είναι άλλου στην είσοδο του. Όπως είδαμε η στην αρχή αρμεί το παρακάτω κύκλωμα για να μοντελοποιήσει αυτό το βημαίο. Ας υποθέσουμε πως η είσοδος  $V_{in}$  είναι ένα τετραγωνικό παλμό



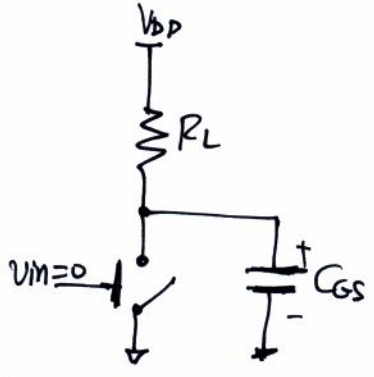
Ανάλογα με την τιμή της εισόδου  $V_{in}$  προκύπτουν τα εξής δύο ισοδύναμα κυκλώματα.

$V_{in}=1 \Rightarrow V_{GS} > V_T$  για το τρανζίστορ άρα άγει (για χρόνο ίσο με  $T_1$ )



Πριν το  $V_{in}=1$  το τρανζίστορ ήταν κλειστό με αποτέλεσμα  $V_{out}=V_{DD}$ . Μετά τη μετάβαση ο πυκνωτής θα αποφορτιστεί μέχρι την τάση  $V_{TH} = \frac{R_{on}}{R_{on}+R_L} \cdot V_{DD}$ .

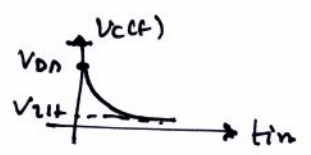
$V_{in}=0 \Rightarrow V_{GS} < V_T$  το τρανζίστορ δεν άγει. (για χρόνο ίσο με  $T_2$ )



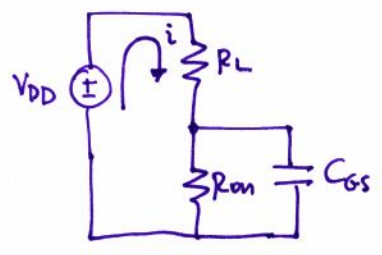
Πριν το  $V_{in}=1$  τσας ο πυκνωτής είχε αποφορτιστεί σε  $V_{TH}$ . Τώρα δεν κινάει ρεύμα. Επομένως  $V_{out}=V_{DD}$

Ας μελετήσουμε τη βωολική ενέργεια για τη δύο μεταβολές της  $V_{in}$ .

▲  $V_{in} \Rightarrow 0 \rightarrow 1$ : Η τάση στα άκρα του πυκνωτή ίση με  $V_{out} = v_c(t) = V_{TH} + (V_{DD} - V_{TH}) e^{-\frac{t}{\tau}}$



όπου  $V_{TH} = \frac{R_{on}}{R_{on}+R_L} \cdot V_{DD}$  και  $\tau = (R_L // R_{on}) \cdot C$



Για να βρούμε τη βωολική ενέργεια που ζοδεύθηκε για χρόνο  $T_1$  ώστε ο πυκνωτής να αποφορτιστεί (ουσιαστικά λόγω της αποφόρτισης ένα μέρος της βωολικής ενέργειας επιτρέφεται στο κύκλωμα.

Αναμένοντας με αρνητικό πρόσημο) πρέπει να βρούμε το ρεύμα  $i$ .

Το ρεύμα  $i$  που διαρρέει την πηγή  $V_{DD}$  διαρρέει και ενώ  $R_L$ . Έτσι η διαφορά δυναμικού στα άκρα της  $R_L$  είναι  $V_{DD} - v_C(t) = i \cdot R_L \rightarrow i = \frac{V_{DD} - v_C(t)}{R_L}$

Επομένως η στιγμιαία ισχύς που καταναλώνει το κύκλωμα είναι  $p(t) = V_{DD} \cdot i \rightarrow$

$$p(t) = V_{DD} \frac{V_{DD} - v_C(t)}{R_L} = V_{DD} \frac{V_{DD} - V_{TH} - (V_{DD} - V_{TH}) e^{-\frac{t}{\tau}}}{R_L} = \frac{V_{DD} (V_{DD} - V_{TH})}{R_L} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) =$$

$$= \frac{V_{DD}}{R_L} \left( V_{DD} - \frac{R_{on}}{R_{on} + R_L} \cdot V_{DD} \right) (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \rightarrow$$

$p(t) = \frac{V_{DD}^2}{R_{on} + R_L} \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ . Η ενέργεια που καταναλώνεται για χρόνο  $T_1$  είναι ίση με

$$E = \int_0^{T_1} p(t) dt = \int_0^{T_1} \frac{V_{DD}^2}{R_{on} + R_L} dt - \int_0^{T_1} \frac{V_{DD}^2}{R_{on} + R_L} e^{-\frac{t}{\tau}} dt =$$

$$= \frac{V_{DD}^2}{R_{on} + R_L} \cdot T_1 - \frac{V_{DD}^2}{R_{on} + R_L} \left[ \tau (e^{-\frac{0}{\tau}} - e^{-\frac{T_1}{\tau}}) \right]$$

Αν θεωρήσουμε την ημι-περίοδο  $T_1$  στο/υ μεγαλύτερη από τη σταθερά χρόνο ( $T_1 \gg \tau$ ) τότε  $e^{-\frac{T_1}{\tau}} \rightarrow 0$ .

Επομένως

$$E_{TOTAL(T_1)} = \frac{V_{DD}^2}{R_{on} + R_L} \cdot T_1 - \frac{V_{DD}^2}{R_{on} + R_L} \cdot \tau = \frac{V_{DD}^2}{R_{on} + R_L} \cdot T_1 - \frac{V_{DD}^2}{(R_{on} + R_L)^2} R_{on} \cdot R_L \cdot C_{GS}$$

Επειδή γνωρίζουμε ότι  $V_{TH} = \frac{R_{on}}{R_{on} + R_L} V_{DD} \hookrightarrow V_{DD} - V_{TH} = \frac{R_L}{R_{on} + R_L} V_{DD}$

μπορούμε να γράψουμε την συνολική ενέργεια ως εξής:

$$E_{TOTAL}^{(T_1)} = \frac{V_{DD}^2}{R_{on} + R_L} \cdot T_1 - \left\{ \frac{V_{DD}}{R_{on} + R_L} \cdot R_L \right\} \left\{ \frac{V_{DD}}{R_{on} + R_L} \cdot R_{on} \right\} C_{GS} \Rightarrow$$

$$E_{TOTAL}^{(T_1)} = \underbrace{\frac{V_{DD}^2}{R_{on} + R_L} \cdot T_1}_{\text{Ανεξάρτητη του πυκνωτή}} - \underbrace{C_{GS} \cdot V_{TH} \cdot (V_{DD} - V_{TH})}_{\text{Ανεξάρτητο των αντιστάσεων}}$$

Ανεξάρτητη του πυκνωτή  
Ανεξάρτητο των αντιστάσεων.

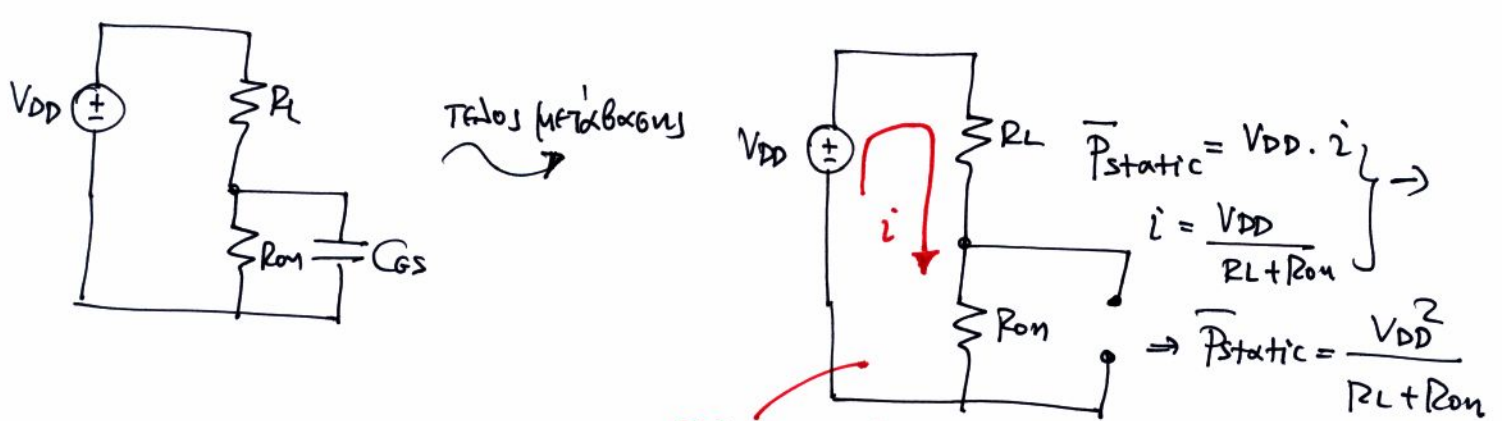
Παρατηρούμε ότι η συνολική ενέργεια για το χρονικό διάστημα  $T_1$  απορροφάται από 2 διακριτά μέρη. Το πρώτο αφορά μόνο τη μεταβίαση και τη διαρροή  $T_1$  ενώ το δεύτερο αφορά στην ενέργεια που απορροφάται από τον πυκνωτή  $C_{GS}$  για να φορτιστεί.

Απόδειξη η βιωσιμότητα της χρονικής διάρκειας μεταβάλλεται αν υπολογίσουμε τη μέση ισχύ. Η μέση ισχύς  $\bar{P}$  ορίζεται σαν το λόγο της βολητικής ενέργειας που δαπανήθηκε για ένα χρονικό διάστημα  $T$  προς το χρόνο από. Έτσι, η μέση ισχύς που καταναλώθηκε όταν  $v_{in} = 0 \rightarrow 1$  είναι

$$\begin{aligned} \bar{P}_1 &= \frac{E_{TOTAL}}{T_1} = \frac{V_{DD}^2}{R_{on} + R_L} - \frac{1}{T_1} C_{GS} V_{IH} (V_{DD} - V_{IH}) = \\ &= \frac{V_{DD}^2}{R_{on} + R_L} + \frac{1}{T_1} C_{GS} V_{IH} (V_{IH} - V_{DD}) \end{aligned}$$

Μετά από αυτήν την ανάλυση προκύπτει τα εξής. Η μέση ισχύς αποτελείται από δύο μέρη. Το κομμάτι της στατικής καταπόνησης ισχύος το οποίο αφορά τη αντίσταση του κυκλώματος και δεν έχει να κάνει με τα μεταβατικά φαινόμενα της φόρτισης ή της αποφόρτισης του πυκνωτή. Το δεύτερο μέρος είναι η δυναμική καταπόνηση ισχύος και αφορά αποκλειστικά την παραγωγή ισχύος κατά τη διάρκεια των μεταβατικών φαινομένων. Η τιμή της δυναμικής καταπόνησης ισχύος βασίζεται μόνο στη τιμή των χωρητικότητας και τη αρχική ή τελική τάση που αυτές λαμβάνουν. Επίσης, η δυναμική μέση ισχύς είναι άμεσα εξαρτημένη από το πόσο γρήγορα συμβαίνουν τα μεταβατικά φαινόμενα ( $1/T_1$ ).

Στατική καταπόνηση ισχύος έχουμε εφόσον στο κύκλωμα μας υπάρχουν βρόχοι οι οποίοι διαρρέονται από ρεύμα ακόμα και αν τα μεταβατικά φαινόμενα ολοκληρωθούν και οι πυκνωτές υπερπεριφερθούν σαν ανοικτοκυκλώματα. Στο κύκλωμα του παραδειγματός μας όταν ολοκληρωθούν τα μεταβατικά φαινόμενα τότε παρουσιάζει το εξής ισοδύναμο κύκλωμα:

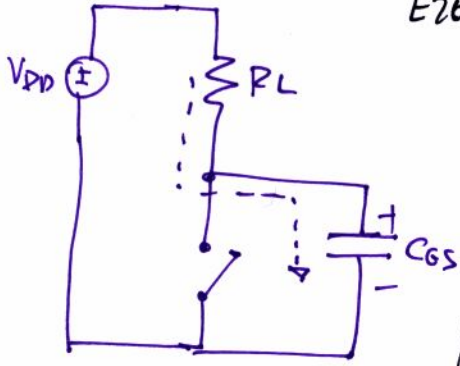


Βρόχοι που διαρρέονται από  $I_{static}$

●  $v_{in} \Rightarrow 1 \rightarrow 0$ : Σάντη τήν περίπτωση ο πυκνωτής φορτίζεται από  $V_{TH}$  ή  $V_{DD}$

$$\text{Έτσι } v_C(t) = V_{DD} + (V_{TH} - V_{DD})e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$V_{TH} = \frac{R_{on}}{R_{on} + R_L} \cdot V_{DD} \quad \tau = R_L \cdot C_{GS}$$



Γνωρίζουμε από την ανάλυση που εξετάσαμε πριν για το απλό RC δίκτυο πως

$$E_{TOTAL}^{(T_2)} = C_{GS} \cdot V_{DD} \cdot (V_{DD} - V_{TH})$$

Έτσι η μέση ισχύς για το διάστημα  $T_2$  θα είναι ίση με  $\bar{P}_2 = \frac{E_{TOTAL}^{(T_2)}}{T_2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \bar{P}_2 = \frac{1}{T_2} C_{GS} V_{DD} (V_{DD} - V_{TH})$$

Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση αυτή η κατανάλωση ισχύος αποτελείται μόνο από ένα δυναμικό κομμάτι και δεν υπάρχει καμιά στατική κατανάλωση. Αυτό είναι λογικό γιατί τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν τα μεταβαρικά φαινόμενα ο πυκνωτής  $C_{GS}$  θα συμπεριφέρεται ως ανοικτοκύκλωμα και έτσι δεν θα υπάρχει ροή ρεύματος η οποία να προκαλεί την στατική κατανάλωση ισχύος έρευνας της αντίστασης  $R_L$ .

Υπολογίζουμε τη στατική μέση ισχύ  $\Rightarrow$  για τη δύο μεταβάσεις παίρνουμε ότι:

$$\bar{P}_{TOTAL} = \frac{E_{TOTAL}^{(T_1)} + E_{TOTAL}^{(T_2)}}{T} = \bar{P}_{TOTAL} = \frac{V_{DD}^2 T_1}{R_L + R_{on} T} + \frac{1}{T} C_{GS} V_{TH} (V_{TH} - V_{DD}) + \frac{1}{T} C_{GS} V_{DD} (V_{DD} - V_{TH})$$

Αν θεωρήσουμε ότι  $T_1 + T_2 = T \Rightarrow$  πως  $T_1 = T_2 = \frac{T}{2}$  τότε:

$$\bar{P}_{STATIC} = \frac{1}{2} \frac{V_{DD}^2}{R_L + R_{on}}$$

$$\begin{aligned} \bar{P}_{DYNAMIC} &= \frac{1}{T} C_{GS} V_{TH} (V_{TH} - V_{DD}) + \frac{1}{T} C_{GS} V_{DD} (V_{DD} - V_{TH}) = \\ &= \frac{1}{T} C_{GS} (V_{DD} - V_{TH})^2 \end{aligned}$$

Παράδειγμα: Για το προηγούμενο ζευγάρι από ανιστροφεύ θεωρήσει ότι  $C_{GS} = 10 \text{ fF}$

$f = \frac{1}{T} = 10 \text{ MHz}$  - Τα σήματα εισόδου δε μπορούν ν'αλλάξουν ταχύτητα από αυτή τη συχνότητα.  $V_{DD} = 5 \text{ Volt}$  και  $R_L = 100 \text{ k}\Omega$  ενώ  $R_{on} = 10 \text{ k}\Omega$ .

Για να ισχύουν οι προηγούμενες σχέσεις πρέπει  $T \gg \tau$ . τότε έχουμε ότι

$$P_{\text{static}} = \frac{1}{2} \frac{V_{DD}^2}{R_L + R_{on}} = \frac{1}{2} \frac{25}{110 \text{ k}\Omega} =$$

$$P_{\text{dynamic}} = \frac{1}{T} C_{GS} (V_{DD} - V_{TH})^2$$

$$V_{TH} = \frac{R_{on}}{R_{on} + R_L} \cdot V_{DD} = \frac{10}{110} 5$$

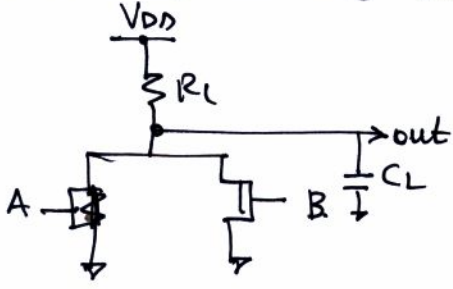
Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος του ανιστροφεύ φοδεύεται βιω στατική κατανάλωση (στις αντιστάσεις  $R_{on}$  &  $R_L$ ) και όχι για τη μεταβολή που προσφέρει το πραγματικό έργο.

Για τον ανιστροφέα που οδηγεί άλλον εία ο λόγος  $\frac{P_{\text{static}}}{P_{\text{dynamic}}}$  είναι 1603 kA

$$\frac{P_{\text{static}}}{P_{\text{dynamic}}} = \frac{R_L + R_{on}}{R_L} \times \frac{T}{2 R_L C_{GS}}$$

Εφόσον για εφί ψηφιακή λειτουργία (χαμηλό  $V_{OL}$ )  $R_L \gg R_{on}$  τότε  $\frac{R_L + R_{on}}{R_L} \rightarrow 1$ . Επίσης εφόσον  $T \gg \tau$  άρα  $T \gg R_L C_{GS}$  επομένως  $P_{\text{static}} \gg P_{\text{dynamic}}$  το οποίο είναι ηο/ο κακό για τη νόση μας.

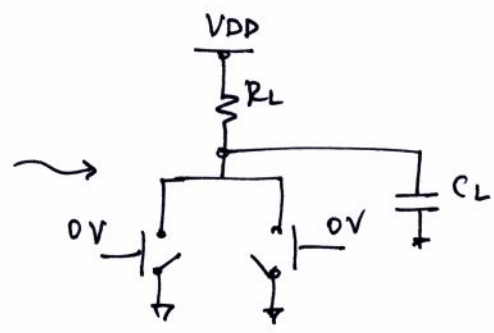
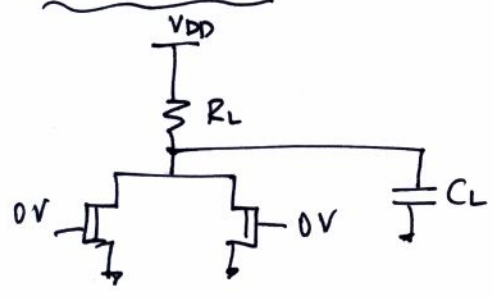
Παράδειγμα: Ποια είναι η στατική κατανάλωση ισχύος της νόση NOR για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των εισόδων.



Στατική κατανάλωση ισχύος έχουμε όταν φετα τη μεταβολή παραμένει βροχίας που διαρρέεται από ρεύμα. Ας δούμε αναλυτικά τις 4 περιπτώσεις:



⊙ A = 0V, B = 0V

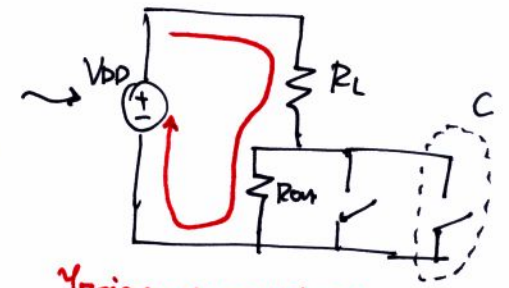
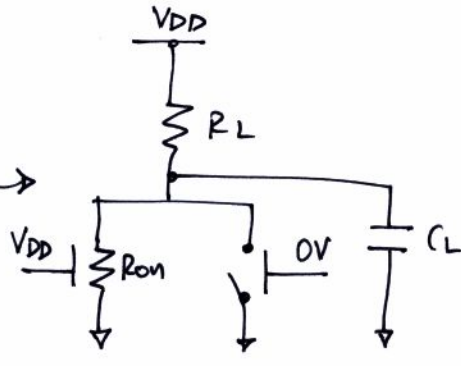
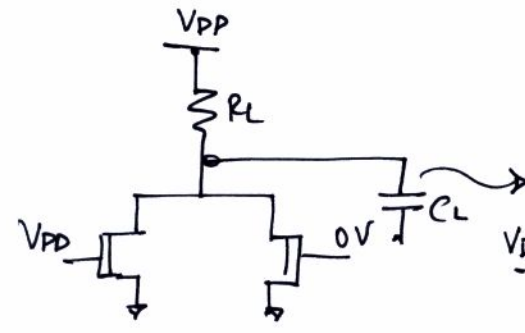


Όταν τελειώσουν τα μεταβατικά φαινόμενα ο πυκνωτής συμπεριφέρεται ως ανοιχτοκύκλωμα

**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΒΡΩΧΟΣ.**

**Δεν έχουμε στατική ισχύ.**

⊙ A = VDD, B = 0V

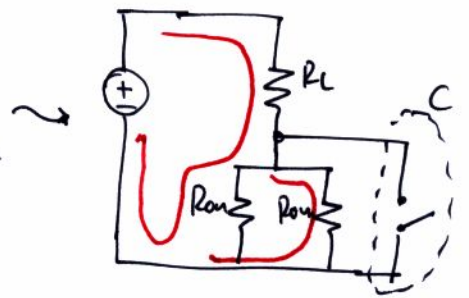
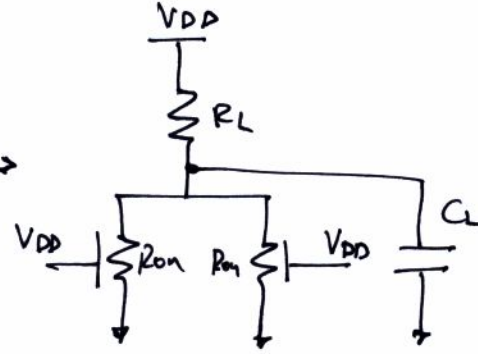
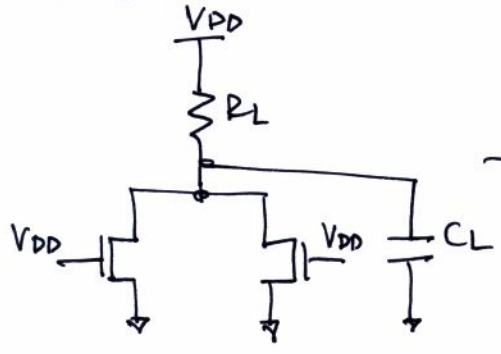


**Υπάρχει στατική ισχύς**

$$P_{static} = \frac{V_{DD}^2}{R_L + R_{on}}$$

⊙ A = 0V, B = VDD (συμμετρική με την προηγούμενη)

⊙ A = VDD, B = VDD



$$P_{static} = \frac{V_{DD}^2}{R_L + (R_{on} // R_{on})} = \frac{V_{DD}^2}{R_L + \frac{R_{on}}{2}}$$

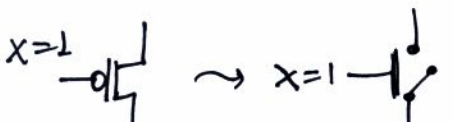
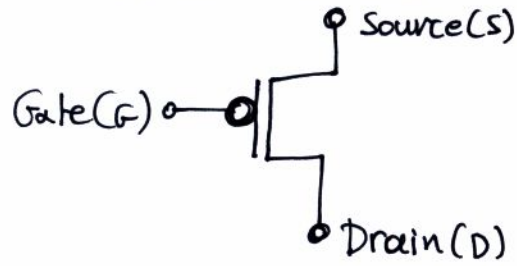
Χειρότερη περίπτωση από πλήρη βραχυκύκλωμα ισχύος

Το μεγάλο ποσοστό της βλαβερής καταπόνησης ισχύος είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα του τρόπου που κατασκευάζονται μέχρι τώρα τα λογικά κύκλωμα. Ουσιαστικά ζοδεύουμε ενέργεια χωρίς οι πύλες μας να υπολογίζουν κάτι μόνο όταν η έξοδος βρίσκεται στο λογικό-0. Ο περιορισμός αυτός κάνει δύσκολη τη χρήση των πυλών αυτών σε φορητές συσκευές όπου ο χρόνος ζωής της μπαταρίας είναι πολύ κρίσιμο μέγεθος. \* Μια μπαταρία χαρακτηρίζεται από τα Amp.h (αμπερώρια) της. Δηλαδή μια μπαταρία των 2 Amp.h σημαίνει ότι μπορεί να παρέχει την ονομαστική τάση για 1 ώρα όταν το ρεύμα που τη διαρρέει - καθορίζεται από το υπόλοιπο κυκλώμα - είναι 2 Amperes. Αντίστοιχα, μπορεί για 2 ώρες αν το ρεύμα είναι 1 A ή 4 ώρες αν το ρεύμα είναι  $\frac{1}{2} A$  \*

Στην ιδανική περίπτωση θα θέλαμε να ζοδεύουμε ισχύ μόνο όταν η έξοδος της πύλης αλλάξει κατάσταση. Όταν δηλαδή εκτελείται ελάχιστος αριθμός υπολογισμών. Τότε ουσιαστικά η μόνη συνιστώσα της ισχύος θα ήταν η δυναμική καταπόνηση ισχύος που αφορά αποκλειστικά τη φόρτιση ή την αποφόρτιση των πυκνωτών κατά τη διάρκεια των μεταβατικών φαινομένων.

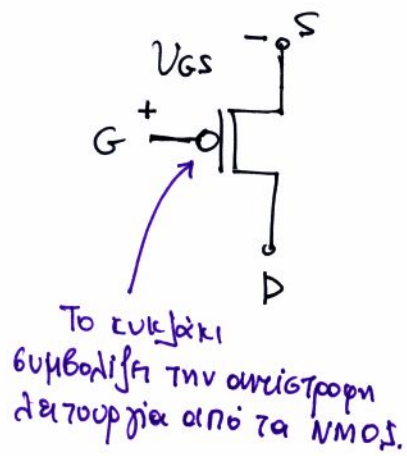
Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σχεδιάζουμε τα κυκλώματά μας. Τα δόξα μας τα δίνει η CMOS λογική στην οποία χρησιμοποιούμε και τα δύο διατάγματα είδη τρανζίστορ. Τα NMOS και τα PMOS. Τα NMOS τρανζίστορ είναι αυτά που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα. Τα PMOS τρανζίστορ εκτελούν τη συμπληρωματική λειτουργία.

⊙ Το PMOS τρανζίστορ:



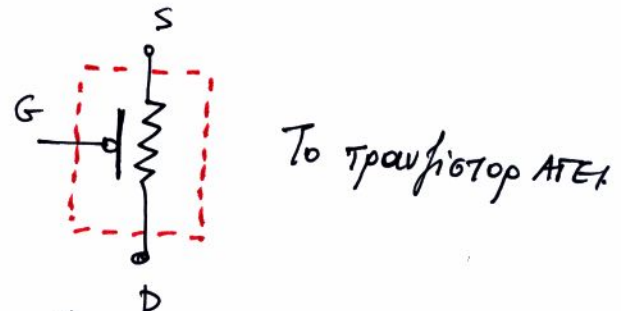
Το PMOS τρανζίστορ αποτελείται και από 3 ακροδέκτες. Αντίθετα με το NMOS ορίζεται ως Source τον ακροδέκτη με το υψηλότερο δυναμικό. Για την περίπτωση του μοντέλου μόνο διακρίνεται το PMOS τρανζίστορ έχει όταν το Gate βρίσκεται στο λογικό-0 ενώ λειτουργεί ως ανοικτό κύκλωμα όταν το Gate είναι στο λογικό-1. (Αντίθετα δηλαδή από το NMOS τρανζίστορ)

Τώρα για την περίπτωση του μοντέλου διακοπής-αντίστασης. Το PMOS τρανζίστορ όταν αγει εμφανίζει και αυτό όπως το NMOS μια αντίσταση μεταξύ του Drain και του Source. Η μόνη διαφορά είναι πως το κατώρι του PMOS  $V_T$  ορίζεται ως μια αρνητική ποσότητα, π.χ.,  $V_T = -0.7 \text{ Volt}$ . Έτσι διακρίνουμε 2 περιπτώσεις:



$V_{GS} > V_T$

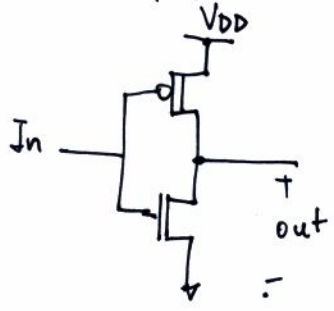
$V_{GS} \leq V_T$



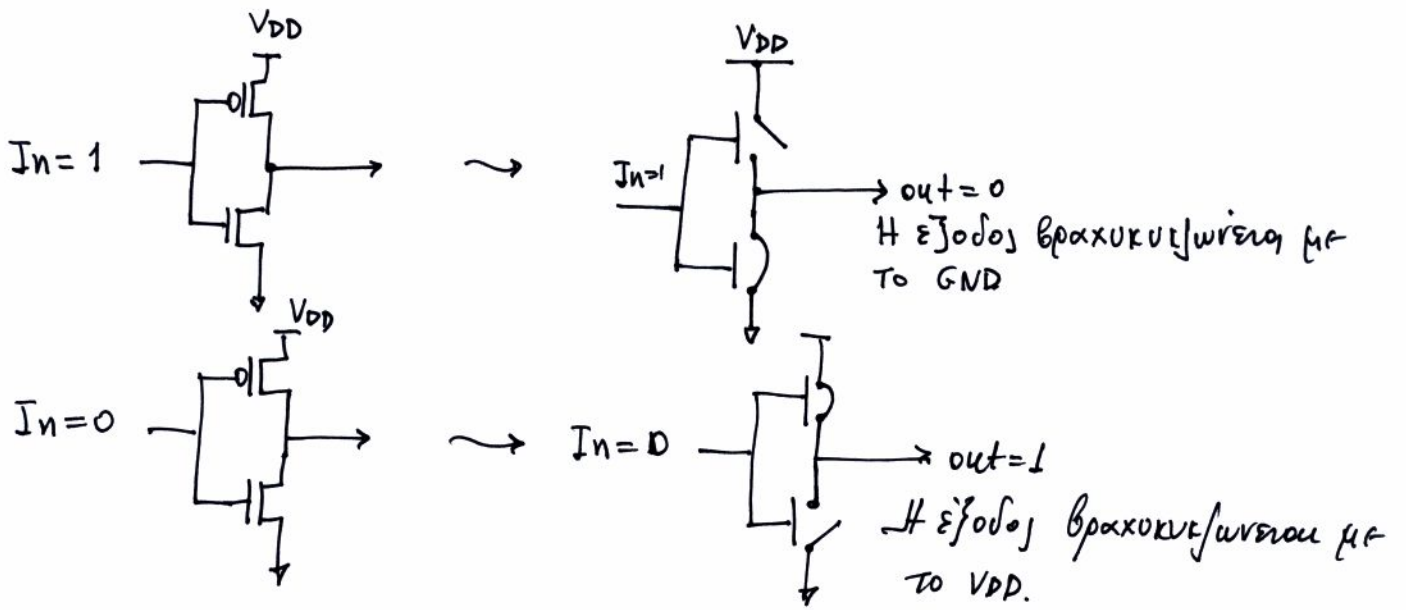
Όπως θα δούμε στη συνέχεια λόγω συνδεσμολογίας συνήθως το source είναι σε υψηλότερο δυναμικό από το gate και άρα το  $V_{GS}$  είναι αρνητικό. Επομένως το τρανζίστορ ανοίγει όταν το  $V_{GS}$  είναι λίγοτερο αρνητικό από το  $V_T$ . Αν θα θέλαμε να συνδυάσουμε τις περιπτώσεις των NMOS τρανζίστορ τότε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις απόλυτες τιμές των  $V_{GS}$  και  $V_T$ . Δηλαδή ισοδύναμα το PMOS αγει όταν  $|V_{GS}| \geq |V_T|$ . Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να φτιάξουμε λογικές πύλες με βάση τη CMOS λογική και πως αυτές καταφέρνουν να εφευρίσκουν (σε πρώτο βαθμό) τη βέλτιστη κατανομή ισχύος που είναι και το  $f_{in} \cdot t_{prop}$ .

● CMOS λογική

Θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση της πιο απλής λογικής πύλης της οικογένειας αυτής, του αντιστροφέα.

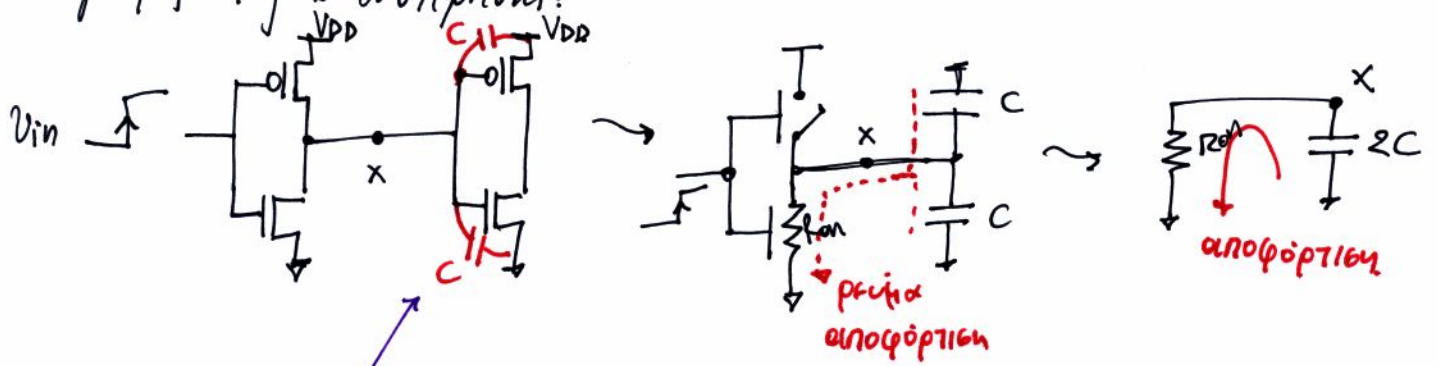


Η είσοδος συνδέεται τώρα σε 2 τρανζίστορ. Σε ένα NMOS όπως και πριν και σε ένα PMOS. Ανάδοξα με την τιμή της εισόδου ενεργοποιείται μόνο ένα από τα 2 τρανζίστορ ποτέ ταυτόχρονα (τουλάχιστον σε επίπεδο ψηφιακής λειτουργίας)

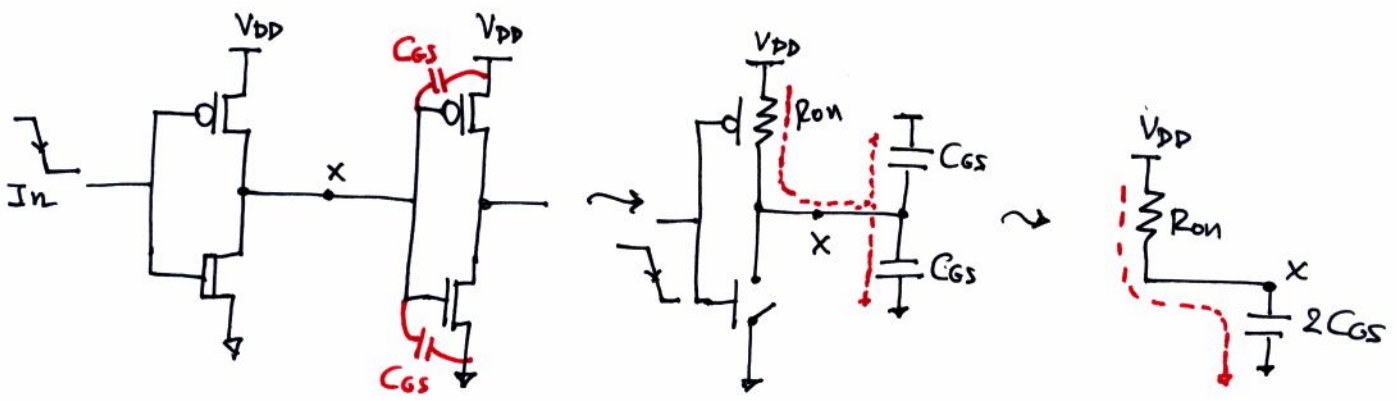


Τυπικά, το NMOS τρανζίστορ αγει όταν  $v_{in} \geq v_T$ . Αντίθετα το PMOS τρανζίστορ αγει όταν  $v_{in} \leq V_{DD} + v_T$  ( $v_T < 0$ ). Με άλλα λόγια αν θεωρήσουμε ένα κοινό η δροκό κατώφλι για τα δύο τρανζίστορ όταν  $v_T \leq v_{in} \leq V_{DD} - v_T$  τότε αγω και τα δύο τρανζίστορ ταυτόχρονα οδηγώντας την έξοδο σε ενδιάμεση τιμή. Για τη ψηφιακή πυξεί αλλι δύο είναι προβλήματα εξόδου το λογικό-0 αναπαριστάται με τάση κοντά στο GND και το λογικό-1 με τάση κοντά στο VDD, ένω διαφέρει από την "επικίνδυνη" περιοχή.

Επειδή στις ακραίες τιμές του λογικού-0 ή λογικού-1 τα δύο τρανζίστορ δεν αγω ταυτόχρονα δεν υπάρχει περίπτωση η πυξεί στο γέλιος της μεταβάσης να διαφρέσει από ρεύμα εξόδου κάποιο από τα 2 τρανζίστορ λειτουργεί ως ανοικτός διακόπτης. Επομένως η έξοδος θα είναι πάντα είτε ίση με VDD είτε ίση με 0Volt χωρίς να έχει τα προβλήματα στο λογικό-0 που είχαν οι πυξεί που σχεδιάζατε μέχρι αυτήν. Επίσης αποδοτικότητα και ο υποδορισμός της καθυστέρησης:

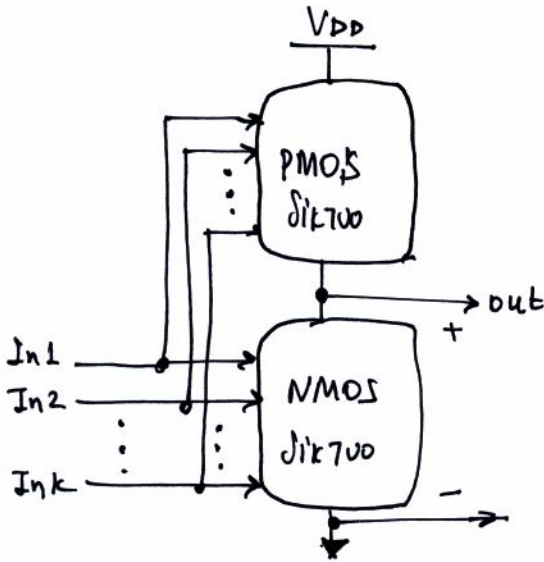


Προβέξτε ότι τώρα ότι χωρητικότητα της εξόδου συμβάλλει τόσο το gate του NMOS τρανζίστορ όσο και τα PMOS διασυνδέεται την καθυστέρηση της πυξεί



### ▲ Σύνδεση CMOS πύλης

Τώρα θα δείξουμε πως μπορούμε να σχεδιάσουμε σύνθετη λογική πύλη CMOS. Μια γενική CMOS πύλη αποτελείται από ένα PMOS δίκτυο και ένα NMOS δίκτυο. Κάθε είσοδος συνδέεται σε τ'όσα PMOS τρανζίστορ όσα και NMOS



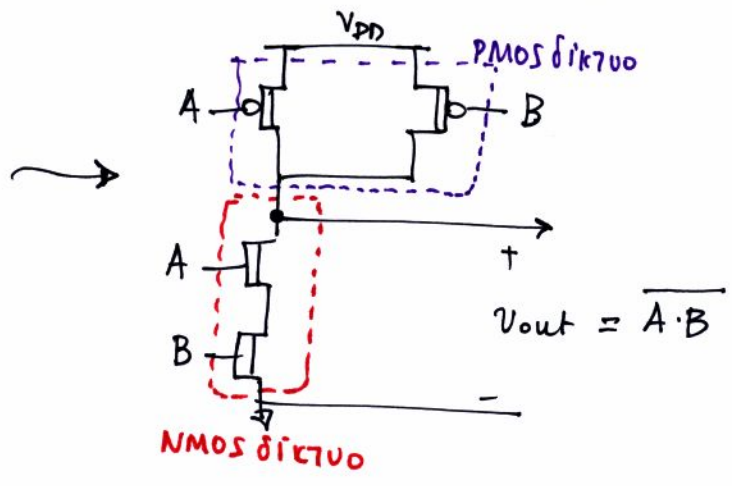
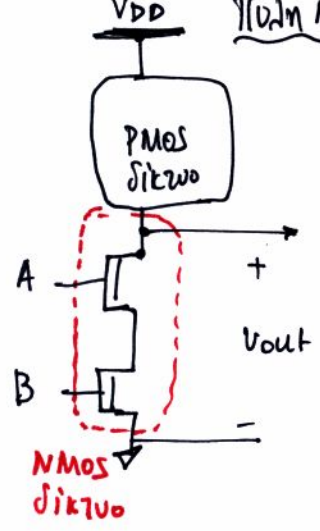
Τα 2 δίκτυα αποτελούν ακριβώς από τον ίδιο αριθμό τρανζίστορ και η λειτουργία τους είναι συμπληρωματική.

Το NMOS δίκτυο σχεδιάζεται όπως ακριβώς σχεδιάζονταν και για τη πύλη που γνωρίσαμε μέχρι τώρα βγάζοντας το κομμάτι της αλυσίδας της εισόδου στο VDD το αναλάμβανε μια αντίσταση  $R_L$  (pull-up resistor). Τώρα τη δουλειά αυτή καλείται να τη εκτελέσει το PMOS δίκτυο. Η σχεδίαση του βασίζεται σε έναν πολύ απλό κανόνα:

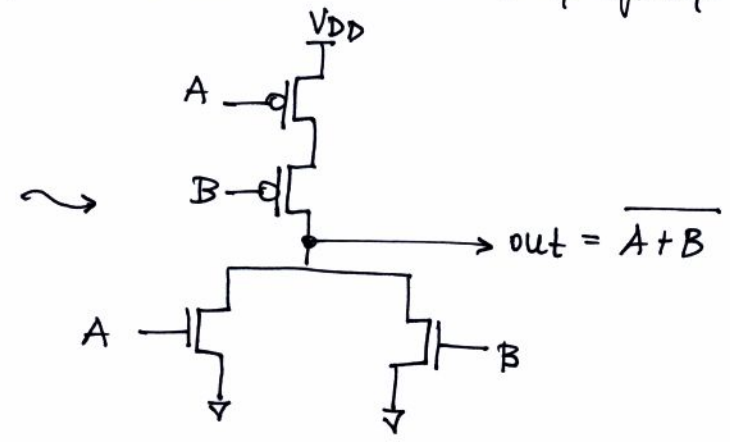
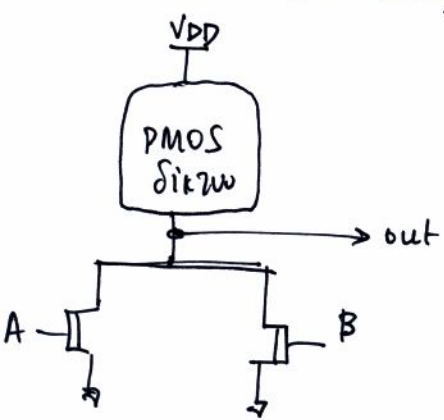
“Όσα τρανζίστορ είναι σε σειρά στο NMOS δίκτυο συνδέονται παράλληλα στο PMOS δίκτυο ενώ όσα τρανζίστορ είναι παράλληλα στο NMOS δίκτυο τα συνδέουμε σε σειρά στο PMOS δίκτυο.”

▲ Ξεκινήσουμε από τη απλή λογική πύλη NAND και NOR για τη οποίες γνωρίζουμε να σχεδιάσουμε το NMOS δίκτυο τους.

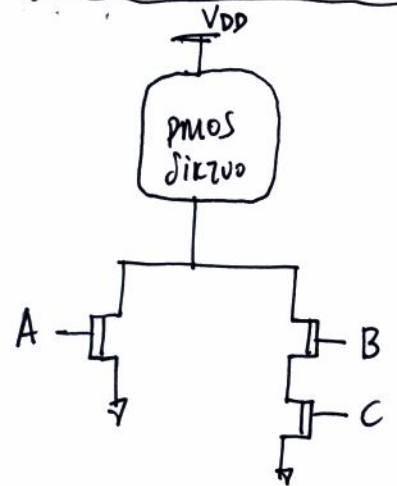
Πύλη NAND: Στο NMOS δίκτυο έχουμε 2 τρανζίστορ σε σειρά. Αρα μετά τον κανόνα πρέπει να υφίσταται ένα PMOS δίκτυο στο οποίο θα έχουμε 2 τρανζίστορ παράλληλα.



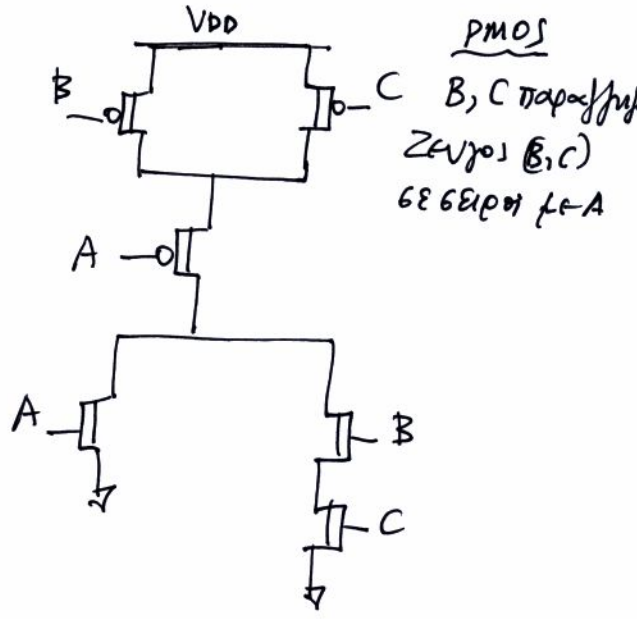
Πύλη NOR: NMOS δίκτυο με 2 τρανζίστορ παράλληλα. Επομένως το PMOS δίκτυο της CMOS πύλης πρέπει να αποτελείται από 2 τρανζίστορ σε σειρά.



Πύλη ΓΟΥΝΔΕΛΗ ΠΥΛΗ ΑΟΙ (AND-OR-INVERT) ⇒ F = A + B · C



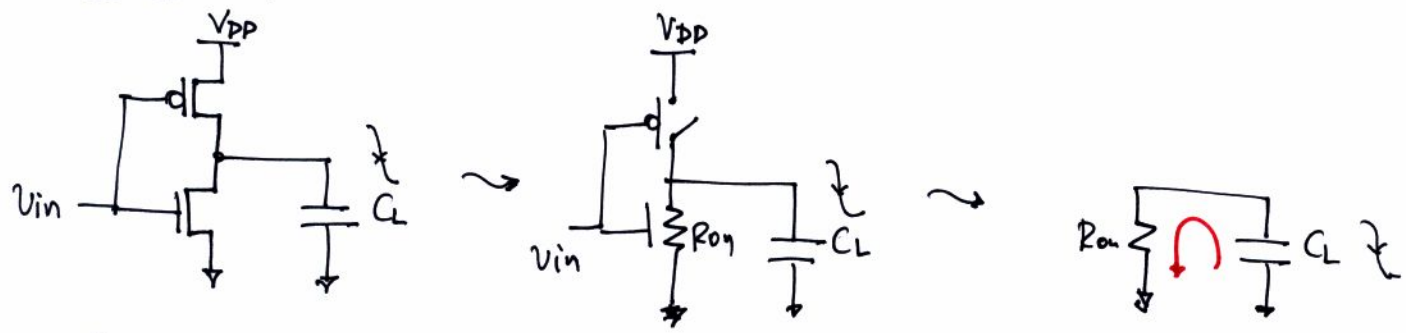
→ NMOS  
B, C σε σειρά  
A παράλληλο σε ζευγος (B, C)



① Υπολογισμός της καταναλώσεως ισχύος πύλων CMOS

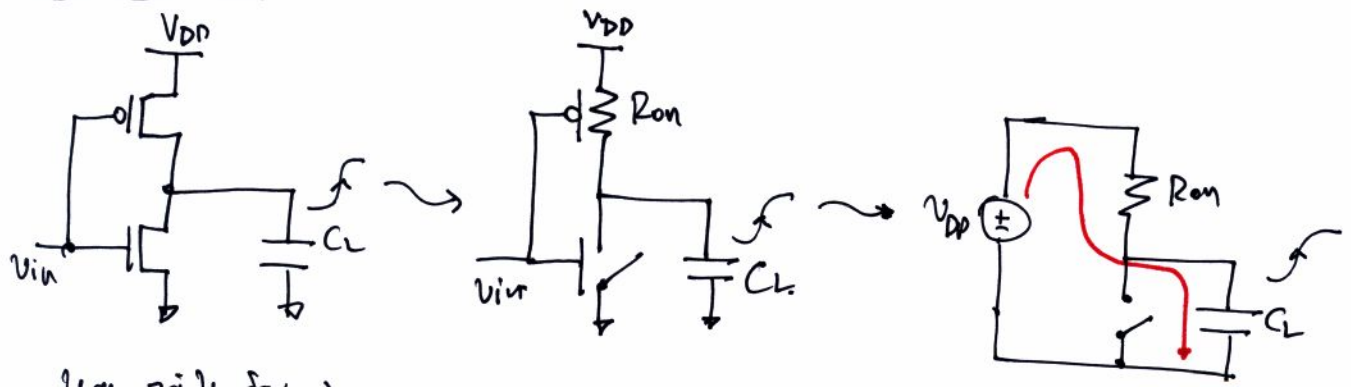
Αφού μάθαμε να σχεδιάζουμε CMOS πύλες και είδαμε το βασικό τρόπο λειτουργίας τους ήρθε η ώρα να αναλύσουμε την κατανομή ισχύος τους. Σίγουρα περίμενα να μην έχει καμμία στατική συνιστώσα αφού αυτή είναι και ο κυρίως λόγος που τις χρησιμοποιούμε. Ας δούμε την περίπτωση ενός ανατροφέα που οδηγεί μια χωρητικότητα  $C_L$  (μοντελοποιεί τη χωρητικότητα του θάτε του τρανζίστοριων επόμενης πύλης) και για τη δύο μεταβάσεις της εισόδου.

$V_{in}: 0 \rightarrow V_{DD}$



Δεν υπάρχει στατική κατανομή ισχύος αφού όταν θα ολοκληρωθούν τα μεταβατικά φαινόμενα ο πυκνωτής ανοιχτοκυκλώσει και η  $R_{on}$  δε θα διαρρέεται από ρεύμα. Ο πυκνωτής αρχικά φορτισμένος σε  $V_{DD}$  και αποφορτίζεται πλήρως σε 0 Volt. (Ο χρόνος απόφορτισης μικρότερος από το χρόνο που ξανακλείει η  $v_{in}$ ). Έτσι η ενέργεια που επεξεργάσθω κύκλωμα  $\frac{1}{2} C V_{DD}^2$  (οδηγώντας την στην αποδημιότητα).

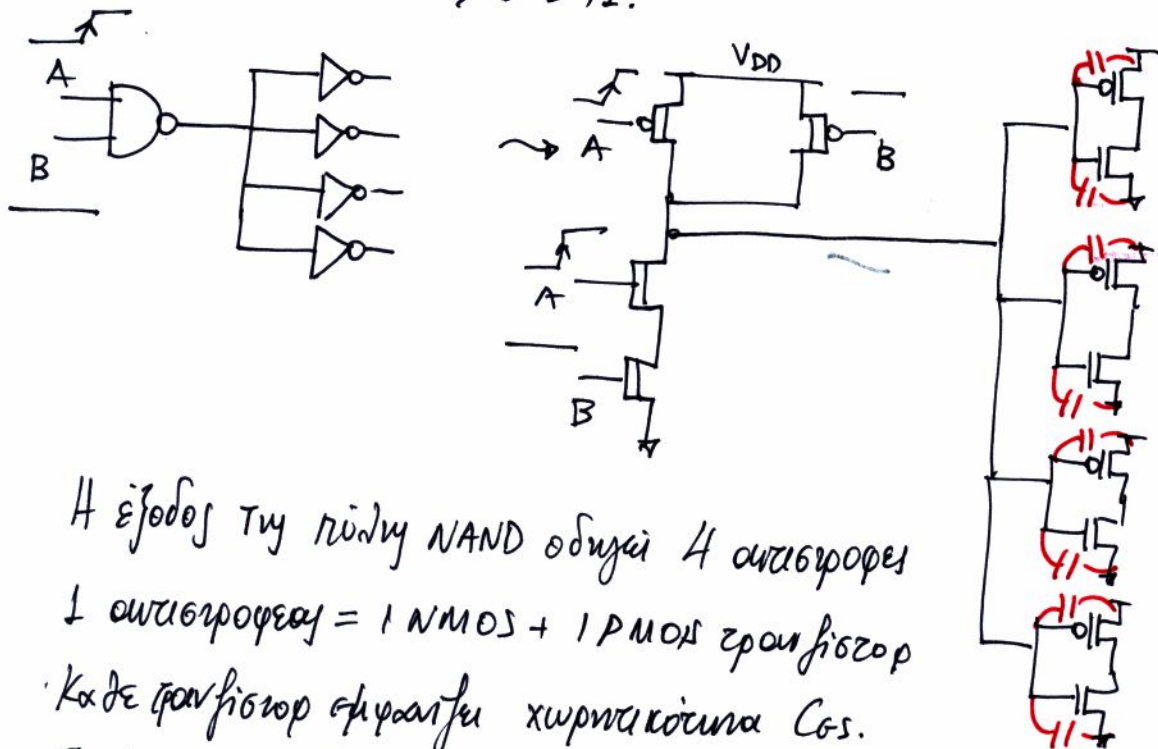
$V_{in}: V_{DD} \rightarrow 0$



και πάλι δεν έχουμε στατική ισχύς παρά μόνο δυναμική κατανομή ενέργειας. Η πηγή τάσης έδωσε για τη φόρτιση ενέργεια  $C_L V_{DD}^2$ . Το  $\frac{1}{2} C_L V_{DD}^2$  αποθηκεύτηκε στον πυκνωτή ενώ το άλλο μισό καταναλώθηκε στην αντίσταση.

Έτσι ουσιαστικά στις CMOS πύλες καταναλώνουμε δυναμική ενέργεια μόνο όταν οι έξοδοι των πυλών κάνουν μεταβολή από το 0 → 1. Στην αντίθετη περίπτωση η αποθηκευμένη ενέργεια επαναπροσφέρεται πίσω στο κύκλωμα και καταλήγει στο GND. Επομένως, το μικρό πλήθος μεταβολών στους κόμβους ενός κυκλώματος οδηγεί πάντα σε μικρή κατανάλωση ισχύος.

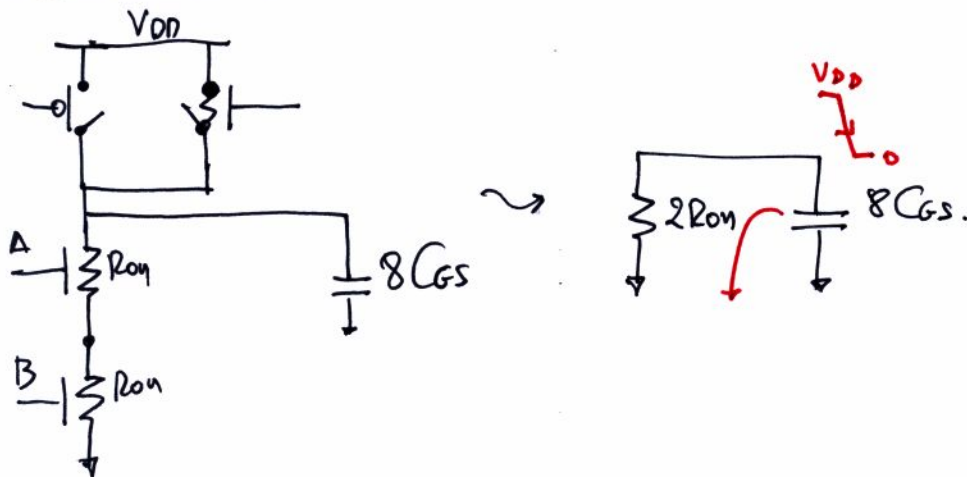
● Ποια είναι η κατανάλωση ισχύος μιας CMOS πύλης NAND που οδηγεί στην έξοδο της 4 αντιστροφές όταν οι είσοδοι κάνουν μεταβολή A: 0 → 1 B: 1 → 1 και όταν A: 0 → 0 B: 1 → 1.



Η έξοδος της πύλης NAND οδηγεί 4 αντιστροφές  
 1 αντιστροφή = 1 NMOS + 1 PMOS τρανζίστορ  
 Κάθε τρανζίστορ εμφανίζει χωρητικότητα  $C_{gs}$ .

Επομένως η έξοδος NAND πύλης οδηγεί χωρητικότητα  $8C_{gs}$ .

Ισοδύναμο Μοντέλο



Η δυναμική ενέργεια που θα επιβραδύσει στο κύκλωμα  
 $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot C_{gs} \cdot V_{DD}^2 = 4C_{gs} V_{DD}^2$   
 (απείριση της αντίστασης)

Στην περίπτωση που το A ή το B δεν κάνουν μεταβολή τότε όχι μεταβολή στην έξοδο δηλαδή έχουμε καθαρά δυναμική κατανάλωση ισχύος



Όσον αφορά στη δυναμική παραγωγή ισχύος δεν πρέπει να ξεχνούμε  
 ότι είναι αίτια εξαρτημένη από τη συχνότητα με την οποία αγγίζου  
 τα βήματα. Η μέση ισχύς είναι  $\bar{p} = \frac{E_{\text{τοπ}}}{T}$  ή  $\bar{p} = E_{\text{τοπ}} \cdot f$  αν θεωρήσ  
 τω το βήμα είναι περιοδικό. Φυσικά από στιγμή τη φορά που το βήμα  
 αλλάζει με απρόβλεπτο χρόνο εκκίνηση που προκαλούν μια μεταβολή από  
 0 σε 1 και αντίστροφα. Έτσι αν ένα βήμα αγγίζει με πιθανότητα  $\alpha$  από  
 0 σε 1 σε κάθε κύκλο τότε η εκτίμηση για τη μέση δυναμική παραγωγή  
 ισχύος είναι ίση με  $\alpha \cdot f \cdot C_{\text{κόπνου}} \cdot V_{DD}^2$ .